

財團法人工業技術研究院 函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人：桂嫚婷

電話：03-5918009

E-mail：manting@itri.org.tw



1120000233008

110202 台北市信義路五段 5 號 3 樓 3E41 室

受文者：台灣電子設備協會

發文日期：中華民國 112 年 01 月 09 日

發文字號：工研轉字第 1120000233 號

速別：普通件

密等：無

附件：如文

主旨：本院擬舉辦「111 年度工研院電子與光電系統研究所 GaN-on-Si 磊晶技術等相關研發成果非專屬授權案」公開說明會，敬請轉知貴會會員等相關廠商把握機會參與本次推廣活動，請查照。

說明：

- 一、為提昇國內廠商智慧財產權之能量，本院將舉辦 111 年度工研院電子與光電系統研究所 GaN-on-Si 磊晶技術等相關研發成果非專屬授權案之公開說明會。
- 二、「授權標的」包含技術 7 件，詳如附件。
- 三、有關本活動詳細資訊，請參考下列網址公告，工研院研發成果公告網站：https://www.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=01_content&SiteID=1&MmmID=1036461244216621372&MGID=1164577072272415754)
- 四、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。
- 五、公開說明會：

(一) 舉辦時間：民國(下同) 112 年 1 月 18 日下午 2

時至 3 時。

(二) 舉辦地點：以線上會議方式舉辦。

(三) 報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 112 年 1 月 17 日中午 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（主旨請註明「111 年度工研院電子與光電系統研究所 GaN-on-Si 磊晶技術等相關研發成果非專屬授權案：公開說明會報名」，並於內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 112 年 1 月 17 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

六、聯絡人：工研院技術移轉與法律中心 桂小姐

電話：+886-3-591-8009

傳真：+886-3-582-0466

電子信箱：ManTing@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣電子設備協會

院長



依權責劃分規定授權業務主管決行



111 年度工研院電子與光電系統研究所

GaN-on-Si 磊晶技術等相關研發成果非專屬授權案

- 一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）。
- 二、非專屬授權標的：本案授權標的包含技術 7 件，詳如附件。
- 三、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。
- 四、公開說明會：
 - （一）舉辦時間：民國（下同）112 年 1 月 18 日下午 2 時至 3 時。
 - （二）舉辦地點：以線上會議方式舉辦。
 - （三）報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 112 年 1 月 17 日中午 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（主旨請註明「111 年度工研院電子與光電系統研究所 GaN-on-Si 磊晶技術等相關研發成果非專屬授權案：公開說明會報名」，並於內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 112 年 1 月 17 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
- 五、聯絡人：工研院技術移轉與法律中心 桂小姐
電話：+886-3-591-8009
傳真：+886-3-582-0466
電子信箱：ManTing@itri.org.tw
地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室



附件：

技術授權標的 (7 件)

件次	產出年度	技術類別	技術名稱	技術特色	可應用範圍	計畫名稱
1	106	半導體光源	大尺寸高品質 8" GaN on Si 磊晶技術報告	包含 GaN on Si 之磊晶及元件技術，Si 基板尺寸可達 6~8 吋，可應用於發光二極體及功率元件。以大面積、高導熱 Si 基板降低成本並提高光電元件效能。	變壓器、電動汽車、馬達驅動器.....等。	智慧型轉能驅動模組與系統技術開發計畫
2	110	半導體光源	8 吋 GaN on Si 無裂縫與翹曲磊晶技術	完成 8 吋 GaN-on-Si 磊晶片，透過調整緩衝層的鋁含量及溫度，降低整體應力與缺陷密度。	GaN B5G/6G 下世代上游關鍵元件需求。	B5G/6G 高頻高頻率電子元件與模組計畫
3	110	半導體光源	8 吋 GaN on Si 超高電導率主動層磊晶技術	完成 8 吋 GaN-on-Si 磊晶片，透過調整 2DEG 的結構，提高通道層的溫度讓碳的摻雜量下降，提升 2DEG 的品質。	GaN B5G/6G 下世代上游關鍵元件需求。	B5G/6G 高頻高頻率電子元件與模組計畫
4	105	半導體光源	高頻氮化鎵之超薄載子通道層磊晶技術	超薄、60GHz 高頻 GaN based MMIC。	GaN B5G/6G 下世代上游關鍵元件需求。	工研院創新前瞻研究計畫
5	111	半導體光源	8 吋 GaN on Si 無裂縫與翹曲磊晶技術	完成 8 吋 GaN-on-Si 磊晶片，透過調整緩衝層的鋁含量及溫度，降低整體應力與缺陷密度。	GaN B5G/6G 下世代上游關鍵元件需求。	B5G/6G 高頻高頻率電子元件與模組計畫
6	111	半導體光源	8 吋 GaN on Si 超高電導率主動層磊晶技術	完成 8 吋 GaN-on-Si 磊晶片，透過調整 2DEG 的結構，提高通道層的溫度讓碳的摻雜量下降，提升 2DEG 的品質。	GaN B5G/6G 下世代上游關鍵元件需求。	B5G/6G 高頻高頻率電子元件與模組計畫
7	111	半導體光源	1700V GaN on ceramic 基板磊晶技術	應用於高電壓、高電流之車載式電池充電器。	變壓器、電動汽車、馬達驅動器.....等。	2030 推動實踐 T 智慧化智能技術